








	<h2>SIJ484DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIJ484DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIJ484DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5900 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIJ484DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5900 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 27.7W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.3 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SIJ484DP-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SIJ484DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIJ484DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIJ484DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIJ800DP-T1-E3 VISHAY SIJ800DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIJ482DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ494DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 150V 36.8A SO8</p>	 <p>SIJ478DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 60A PPAK SO-8</p>
 <p>SIJ800DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 20A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ478DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ484DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ494DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 36.8A SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

08055A470JAQ2A	12065C104JA12A	24AA32AT-I/SN SOP8	ADS54T04IZAYR	B170B-13-F
BUK7L11-34ARC	CDBU0230L-HF	CL05C121JB5NNND	CLVTH16240IDGGREP	CM600DX-24S
CY28352OCT	DEA202450BT-7100C1	DSA403-48GG	FP20R06YE3-B4EN	GP2W3270XP0F
GRM1555C1H4R7CZ01D	GRM1556R1H8R2DZ01D	GRM2195C2A9R1DZ01D	IRF6603TR	KDS121V-RTK/P
LM4120AIM5X-2.5	LP3918TLX-A/NOPB	LT1080CN	MAX4751EUD+T	MMBT3904W
NCP3418BMNR2G	P1504BDG	PQ015YZ5M	RC1117S25T	RF3109TR13XE
SI2493-C-FSR	SIJ400DP-T1-GE3	SIJ400DP-T1-GE3	SIJ420DP-T1-GE3	SIJ420DP-T1-GE3
SIJ458DP-T1-E3	SIJ462DP-T1-GE3	SIJ462DP-T1-GE3	SIJ484DP-T1-GE3	SIJ800DP-T1-E3
SMV1212-001	SN65LVPE512RMQR	SRF10200CT	TAS5615DKD	TPIC6A595DW
UPD70F3286YGJ-UEN	US1DWF-7	VR1005CCA080-T	XCV200-4BG256C	YST60-25P26C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited